Зарождение микротрещин при дислокационных взаимодействиях в монокристаллическом Ti₃AI

© Л.Е. Карькина, Л.И. Яковенкова

Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук, 620219 Екатеринбург, Россия

E-mail: yakovenkova@imp.uran.ru

(Поступила в Редакцию в окончательном виде 28 ноября 2007 г.)

Рассмотрены реакции взаимодействия между сверхдислокациями, осуществляющими деформацию в плоскостях базиса, призмы и пирамиды (I и II типов) в монокристаллическом Ti_3Al . Установлены типы взаимодействий, которые приводят к образованию дислокационных барьеров — зародышей микротрещин. Рассмотрены силовые и энергетические условия формирования микротрещин. При взаимодействии **a**- и 2c + a-сверхдислокаций плоскостями раскрытия микротрещин являются плоскости базиса и пирамиды; взаимодействие 2c + a-сверхдислокаций в различных плоскостях пирамиды приводит к образованию микротрещин в плоскостях призмы и пирамиды; взаимодействие **a**-сверхдислокаций в плоскостях базиса и/или призмы не приводит к образованию дислокационных барьеров. Проведена классификация типов микротрещин в зависимости от ориентации осей деформирования монокристаллов и выделены области стереографического треугольника, характеризуемые преимущественным типом раскрытия трещин.

Работа поддержана грантом РФФИ № 04-02-17311

PACS: 61.72.Ff, 61.72.Hh, 61.72.Lk, 62.20.Mk

1. Введение

Интерметаллид Ті₃Аl, обладающий упорядоченной гексагональной сверхструктурой DO₁₉, является основной составляющей ряда однофазных и двухфазных сплавов [1], перспективных для практического применения в качестве жаропонижающих и жаростойких материалов. Эти интерметаллиды имеют низкую плотность, высокую стойкость к окислению, которая сочетается с хорошими механическими свойствами при повышенных температурах. Подобно многим интерметаллическим соединениям, Ti₃Al обладает низкой пластичностью при комнатной температуре, что препятствует его активному практическому применению. Экспериментальные исследования последних лет [2,3] обнаружили сильную ориентационную зависимость предела текучести σ_v , существование сложной структуры дислокационного ансамбля, включающей многообразие векторов Бюргерса и плоскостей скольжения сверхдислокаций в монокристаллическом Ti₃Al. В зависимости от условий эксперимента (температура, скорость деформации, ориентация оси деформирования и т.д.) реализуется скольжение **a**-, c + a-, 2c + a-сверхдислокаций в плоскости базиса, призмы и пирамиды. Наиболее легкой модой деформации Ti₃Al является призматическое скольжение $1/3 < \langle 11\bar{2}0 \rangle \{1\bar{1}00\}$. В плоскости базиса (0001) деформация также осуществляется а-сверхдислокациями с вектором Бюргерса 1/3(1120). Предел текучести в плоскости базиса $\sigma_{v} \sim 250 \,\mathrm{MPa}$, в плоскости призмы $\sigma_{\rm v} \sim 150{-}200\,{
m MPa}$, т.е. для обеих плоскостей предел текучести имеет достаточно низкое значение. Существенное различие наблюдается экспериментально в значениях деформации до разрушения: для призматического скольжения деформация достигает величины $\varepsilon \sim 250\%$, тогда как при базисном скольжении образец разрушается хрупко после деформации $\varepsilon \leq 1-3\%$. Для близких к с-направлению ориентировках оси деформирования [0001] деформация осуществляется скольжением 2c + а-сверхдислокаций в плоскостях пирамиды [2–7], предел текучести при комнатной температуре составляет величину $\sigma_y \sim 1000-1300$ MPa (пластичность $\varepsilon < 1\%$), $\sigma_y(T)$ для пирамидального скольжения демонстрирует аномальную зависимость с максимумом на кривой $\sigma_y(T)$.

Как правило, для упорядоченных сплавов высокие прочностные свойства сочетаются с низкими пластическими характеристиками. Например, в интерметаллидах со сверхструктурой $L1_2$ пик на кривой зависимости $\sigma_y(T)$ сопровождается минимумом пластичности вблизи температуры пика. Атомистическое моделирование механизмов образования пластической зоны в вершине трещины показало [8], что хрупкое раскрытие трещин обусловлено отсутствием пластической зоны в вершине трещины в таких интерметаллидах, как CoAl, Ti–Al–Nb.

Для монокристаллов $T_{i_3}Al$, ориентированных для $1/3\langle 11\bar{2}0\rangle \{1\bar{1}00\}$ - и $1/3\langle 11\bar{2}0\rangle (0001)$ -скольжения, значения предела текучести близки, тогда как значения деформации до разрушения различаются в сотни раз. Механизм образования микротрещин сдвигового типа при взаимодействии винтовых **a**-сверхдислокаций в полосе скольжения плоскости базиса предложен в [9,10]. Модель основана на результатах компьютерного моделирования структуры ядра **a**-сверхдислокаций в $T_{i_3}Al$ [11,12]. Образование и слияние микротрещин приводят к хрупкому разрушению монокристаллического $T_{i_3}Al$, ориентированного для базисного скольжения. Возможность зарождения микротрещин в $T_{i_3}Al$ в результате дислокационных реакций при электронно-микроскопическом изучении показана в [13].

Механизм хрупкого разрушения при дислокационных взаимодействиях был предложен Коттреллом [14] для ОЦК-металлов и сплавов. В [15] подобный механизм зарождения микротрещин был рассмотрен для интерметаллида TiAl. В упорядоченных сплавах число действующих систем скольжения возрастает по сравнению с чистыми металлами вследствие понижения симметрии кристаллической решетки. Кавабата и др. [15] рассмотрели взаимодействие между всеми действующими в TiAl скользящими дислокациями: одиночными и сверхдислокациями двух типов. В ТізАІ число типов дислокационных взаимодействий возрастает, так как увеличивается не только число вектора Бюргерса сверхдислокаций (а, $2\mathbf{c} + \mathbf{a}$), но и число действующих плоскостей скольжения (призма, базис, пирамиды I и II типов). При рассмотрении результатов дислокационных взаимодействий следует также учитывать существенное различие величины предела текучести для призматического, базисного и пирамидального скольжения и ориентационную зависимость действующих систем скольжения.

Целью настоящей работы является последовательное рассмотрение геометрии и силовых условий образования зародышевой микротрещины, возникающей при дислокационных взаимодействиях, с учетом всех экспериментально наблюдаемых систем скольжения сверхдислокаций в Ti₃Al; проведение детального анализа ориентационной зависимости типов и кристаллогеометрических характеристик образующихся микротрещин.

2. Результаты расчетов

В механизме Коттрелла рассматривается взаимодействие дислокаций, принадлежащих двум пересекающимся плоскостям скольжения (рис. 1, a). Обычно рассматривается взаимодействие двух дислокаций, оси которых параллельны линии пересечения их плоскостей скольжения. В реальной системе взаимодействующих дислокаций они могут быть искривлены из-за влияния внешнего напряжения или напряжений, создаваемых другой дислокацией в момент пересечения. В [16] показано, что влияние этих факторов, а также учет упругой анизотропии имеют незначительное влияние на конечный результат взаимодействия. Рассматриваемая в настоящей работе схема взаимодействующих параллельных дислокаций в изотропной теории упругости является достаточной для того, чтобы предсказать, приводит взаимодействие двух дислокаций к образованию конфигурации типа junction или к их пересечению.

В [17,18] предложен механизм термоактивированного превращения скользящих $2\mathbf{c} + \mathbf{a}$ -сверхдислокаций в дислокационные барьеры в плоскостях пирамиды I и II типа, объясняющий аномальную температурную зависимость предела текучести при пирамидальном скольжении. В широком интервале температур, где $\sigma_y(T)$ имеет аномальное возрастание предела текучести, $2\mathbf{c} + \mathbf{a}$ -сверхдислокации являются неподвижными заблокированными, поэтому их взаимодействие с другими подвижными дислокациями может приводить к образованию



Рис. 1. Схема образования дислокационного барьера — зародыша микротрещины — при пересечении дислокаций с векторами Бюргерса \mathbf{b}_1 и \mathbf{b}_2 . *a* — результирующая дислокация \mathbf{b} лежит вдоль линии пересечения плоскостей скольжения P_1 и P_2 реагирующих дислокаций; *b* — результирующая дислокация \mathbf{b} лежит вдоль оси заблокированной дислокации \mathbf{b}_1 . Дислокационный барьер образуется, если возможно поперечное скольжение дислокации с вектором Бюргерса \mathbf{b}_2 из плоскости скольжения P_2 в плоскость P_1 .

зародышевых микротрещин с другими кристаллогеометрическими характеристиками, так как заблокированная сверхдислокация может и не быть параллельной линии пересечения взаимодействующих систем скольжения. Образование дислокационного барьера происходит в том случае, если возможно поперечное скольжение подвижной дислокации в плоскость, содержащую заблокированную дислокацию (рис. 1, *b*).

Если в результате дислокационной реакции между подвижными дислокациями вдоль линии пересечения их плоскостей скольжения образуется дислокационный барьер, то это может вызвать появление микротрещины. Обозначим через \mathbf{n}_{Σ} нормаль к плоскости, содержащей суммарный вектор Бюргерса дислокаций, вступивших в дислокационную реакцию, а через l — вектор направленный вдоль линии пересечения плоскостей скольжения. Нормаль к плоскости раскрытия возможной трещины определяется соотношением $[\mathbf{n}_{\Sigma} \cdot \mathbf{l}]$. Рост микротрещины обеспечивается поглощением других дислокаций под действием внешних напряжений и напряжений, создаваемых дислокациями в скоплении.

Энергия взаимодействия на единицу длины между двумя параллельными взаимодействующими дислокациями



Рис. 2. Элементарная ячейка сверхструктуры *DO*₁₉. Показаны векторы Бюргерса и плоскости скольжения сверхдислокаций в Ti₃Al.

имеет вид [14]:

$$W = -\Psi(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2) \ln \frac{R}{R_0},\tag{1}$$

где

$$\begin{split} \psi(\mathbf{b}, \mathbf{b}_2) &= \frac{G}{2\pi (1-\nu)} \{ (\mathbf{b}_1 \xi) (\mathbf{b}_2 \xi) (1-\nu) \\ &+ [(\mathbf{b}_1 \times \xi) (\mathbf{b}_2 \times \xi)] \} = \frac{G}{2\pi (1-\nu)} \tilde{\Psi}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2), \end{split}$$

b₁, **b**₂ — векторы Бюргерса взаимодействующих дислокаций; ξ — ось взаимодействующих дислокаций, параллельная линии пересечения плоскостей скольжения этих дислокаций; R — расстояние между взаимодействующими дислокациями; R_0 — константа, имеющая размерность R; G, ν — модуль сдвига и коэффициент Пуассона. Если сила взаимодействия между дислокациями ($\mathbf{F} = -\frac{\partial W}{\partial R}$) $\mathbf{F} > 0$, то дислокации отталкиваются, если же $\mathbf{F} < 0$, то они притягиваются; при $\mathbf{F} = 0$ дальнодействующего взаимодействия между дислокациями нет, но дислокационная реакция может происходить в поле напряжений дислокационного скопления и внешних напряжений.

Экспериментально и теоретически показано, что деформация Ti_3Al может осуществляться скольжением а-сверхдислокаций с вектором Бюргерса $1/3\langle 11\bar{2}0\rangle$ по плоскостям базиса (0001) и призмы $\{1\bar{1}00\}$ и скольжением $2\mathbf{c} + \mathbf{a}$ -сверхдислокаций с вектором Бюргерса $1/3\langle 11\bar{2}6\rangle$ по плоскостям пирамиды I и II типа $\{20\bar{2}1\}$ или $\{11\bar{2}1\}$ (рис. 2). Сверхдислокации в плоскостях базиса и призмы расщеплены с образованием антифазной границы (АФГ) в соответствии с реакцией

$$1/3\langle 11\bar{2}0\rangle \to 1/6\langle 11\bar{2}0\rangle + A\Phi\Gamma + 1/6\langle 11\bar{2}0\rangle.$$
(2)

Энергия АФГ в плоскости базиса $\xi_{(0001)} = 161 \text{ mJ/m}^2$, а в плоскости призмы $\xi_{\{1100\}} = 6 \text{ mJ/m}^2$ [19]. Сверхдислокации в плоскостях пирамиды также расщеплены с

образованием АФГ

$$1/3\langle 11\bar{2}6\rangle \to 1/6\langle 11\bar{2}6\rangle + A\Phi\Gamma + 1/6\langle 11\bar{2}6\rangle.$$
 (3)

Энергия АФГ в плоскости пирамиды I типа $\xi_{\{2021\}} = 205 \text{ mJ/m}^2$, пирамиды II типа $\xi_{\{1121\}} = 228 \text{ mJ/m}^2$. Компьютерное моделирование структуры ядра сверхдислокаций показало [11,12,20,21], что во всех плоскостях скольжения сверхчастичные дислокации можно считать нерасщепленными.

Рассмотрим дислокационные взаимодействия между притягивающимися дислокациями с учетом действующих плоскостей скольжения и векторов Бюргерса сверхдислокаций, которые осуществляют пластическую деформацию в Ti₃Al. Возможны четрые типа взаимодействий: 1) между **a**-сверхдислокациями, скользящими в двух плоскостях призмы или в плоскостях призмы и базиса; 2) между **a**-сверхдислокациями в плоскостях базиса и 2**c** + **a**-сверхдислокациями в плоскостях базиса и 2**c** + **a**-сверхдислокациями в плоскостях пирамиды I и II типа; 3) между **a**-сверхдислокациями в плоскостях пирамиды I и II типа; 4) между 2**c** + **a**-сверхдислокациями, скользящими в плоскостях пирамиды I и II типа.

2.1. Дислокационные реакции между а-сверхдислокациями. Типичная дислокационная реакция между расщепленными притягивающимися а-сверхдислокациями (реакция (2)), скользящими в двух пересекающихся плоскостях призмы, имеет следующий вид:

$$\begin{split} (1/6[1\bar{2}10] + A\Phi\Gamma + 1/6[1\bar{2}10])_{(\bar{1}010)} + (1/6[\bar{2}110] \\ &+ A\Phi\Gamma + 1/6[\bar{2}110])_{(0\bar{1}10)} \rightarrow (1/6[1\bar{2}10] + A\Phi\Gamma)_{(\bar{1}010)} \\ &+ 1/6[\bar{1}\bar{1}20]_{[0001]} + (A\Phi\Gamma + 1/6[\bar{2}110])_{(0\bar{1}10)}. \end{split}$$

Образующаяся в результате взаимодействия дислокация $1/6[\bar{1}120]$ лежит вдоль направления [0001], совпадающего с линией пересечения плоскостей призмы (табл. 1). Эта дислокация является подвижной в плоскости призмы ($\bar{1}100$), которая не совпадает с плоскостями скольжения реагирующих $\mathbf{a}/2$ -сверхдислокаций. Скольжение $1/6[\bar{1}120]$ -дислокаций в плоскости ($\bar{1}100$) приводит к реакции, подобной (4), между оставшимися $\mathbf{a}/2$ -сверхдислокациями, ограничивающими полосу АФГ. В результате \mathbf{a} -сверхдислокация с вектором Бюргерса $1/3[\bar{1}120]$ может скользить в плоскости призмы ($\bar{1}100$). Таким образом, взаимодействие \mathbf{a} -сверхдислокаций в плоскостях призмы не приводит к образованию зародышей микротрещин.

Типичная дислокационная реакция между расщепленными (реакция (2)) **а**-сверхдислокациями, скользящими в пересекающихся плоскостях базиса и призмы, имеет вид:

$$(1/6[\bar{2}110] + A\Phi\Gamma + 1/6[\bar{2}110])_{(0001)} + (1/6[1\bar{2}10] + A\Phi\Gamma + 1/6[1\bar{2}10])_{(\bar{1}010)} \rightarrow (1/6[\bar{2}110] + A\Phi\Gamma)_{(0001)} + 1/6[\bar{1}\bar{1}20]_{[\bar{1}2\bar{1}0]} + (A\Phi\Gamma + 1/6[1\bar{2}10])_{(\bar{1}010)}.$$
(5)

Образующаяся в результате взаимодействия дислокация с вектором Бюргерса 1/6[1120] лежит вдоль ли-

Таблица 1. Дислокационные реакции и ожидаемые плоскости разрушения при взаимодействии а-сверхдислокаций

Номер	Вектор Бюргерса	Ось результирующей	Ожидаемая плоскость		
реакции	результирующей дислокации	дислокации	разрушения		
(4)	1/6[ĪĪ20]	[0001]	Трещина не образуется		
(5)	1/6[ĪĪ20]	[Ī2Ī0]	Трещина не образуется		

Таблица 2. Дислокационные реакции и ожидаемые плоскости разрушения при взаимодействии а-сверхдислокаций плоскости базиса и 2с + а-сверхдислокаций плоскостей пирамиды I и II типа

Номер	Вектор Бюргерса	Ось результирующей	Ожидаемая плоскость
реакции	результирующей дислокации	дислокации	разрушения
(6)	[0001]	[ĪĪ20]	(0001)
(7)	1/6[ĪĪ26]	[ĪĪ20]	(0001)
(8)	[0001]	[0Ī10]	(0001)
(9)	1/6[ĪĪ26]	[Ī010]	(0001)

нии [1210] пересечения плоскостей базиса и призмы (табл. 1). Эта дислокация является подвижной в плоскости базиса (0001). Таким образом, как и для реакции (4), взаимодействие **а**-сверхдислокаций в плоскостях базиса и призмы не приводит к образованию зародышевой микротрещины.

2.2. Дислокационные реакции между а-сверхдислокациями в плоскости базиса и 2с + а-сверхдислокациями в плоскостях пирамиды. Между расщепленными а-сверхдислокациями в плоскости базиса и 2с + а-сверхдислокациями в плоскости пирамиды I типа возможны два различных варианта дислокационных реакций:

$$(1/6[\bar{2}110] + A\Phi\Gamma + 1/6[\bar{2}110])_{(0001)} + (1/6[2\bar{1}\bar{1}6] + A\Phi\Gamma + 1/6[2\bar{1}\bar{1}6])_{(\bar{2}201)} \rightarrow (1/6[\bar{2}110] + A\Phi\Gamma)_{(0001)} + [0001]_{[\bar{1}\bar{1}20]} + (A\Phi\Gamma + 1/6[2\bar{1}\bar{1}6])_{(\bar{2}201)};$$
(6)

$$(1/6[\bar{2}110] + A\Phi\Gamma + 1/6[\bar{2}110])_{(0001)} + (1/6[1\bar{2}16] + A\Phi\Gamma + 1/6[1\bar{2}16])_{(\bar{2}201)} \rightarrow (1/6[\bar{2}110] + A\Phi\Gamma)_{(0001)} + 1/6[\bar{1}\bar{1}26]_{[\bar{1}\bar{1}20]} + (A\Phi\Gamma + 1/6[1\bar{2}16])_{(\bar{2}201)}.$$
(7)

Результирующие дислокации имеют векторы Бюргерса [0001] (реакция (6)) и 1/6[$\overline{1}\overline{1}26$] (реакция (7)); в обоих случаях направление оси [$\overline{1}\overline{1}20$]. Эта конфигурация является дислокационным барьером; возможной плоскостью раскрытия трещины является плоскость (0001) (табл. 2). Отметим, что при высоких температурах деформирования ($T > 800^{\circ}$ С) экспериментельно наблюдалось скольжение дислокаций с вектором Бюргерса [0001], тогда как при более низких температурах эти дислокации неподвижны [22,23].

При взаимодействии **a**-сверхдислокаций в плоскости базиса и 2**c** + **a**-сверхдислокаций в плоскости пирамиды II типа возможны также два различных варианта дислокационных реакций:

$$(1/6[\bar{2}110] + A\Phi\Gamma + 1/6[\bar{2}110])_{(0001)} + (1/6[2\bar{1}\bar{1}6] + A\Phi\Gamma + 1/6[2\bar{1}\bar{1}6])_{(\bar{2}111)} \rightarrow (1/6[\bar{2}110] + A\Phi\Gamma)_{(0001)} + [0001]_{[0\bar{1}10]} + (A\Phi\Gamma + 1/6[2\bar{1}\bar{1}6])_{(\bar{2}111)};$$
(8)

$$(1/6[2110] + A\Phi\Gamma + 1/6[2110])_{(0001)} + (1/6[1216])_{(0001)}$$

$$+ A\Phi\Gamma + 1/6[1216])_{(\bar{1}2\bar{1}1)} \rightarrow (1/6[2110] + A\Phi\Gamma)_{(0001)}$$

$$+ 1/6[\bar{1}\bar{1}26]_{[\bar{1}010]} + (A\Phi\Gamma + 1/6[1\bar{2}16])_{(\bar{1}2\bar{1}1)}.$$
 (9)

Направления осей результирующих дислокаций $\langle 1\bar{1}00 \rangle$, возможная плоскость раскрытия трещины (0001). Таким образом, при взаимодействии **а**-сверхдислокаций, принадлежащих плоскости базиса, и **2с** + **а**-сверхдислокаций, скользящих в плоскостях пирамиды I и II типа, возможно зарождение микротрещины в плоскостях базиса (0001).

2.3. Дислокационные реакции между а-сверхдислокациями в плоскости призмы и 2c + а-сверхдислокациями в плоскостях пирамиды. При взаимодействии а-сверхдислокации в плоскости призмы и 2c + а-сверхдислокации в плоскостях пирамиды I типа возможны три различных варианта:

$$(1/6[\bar{2}110] + A\Phi\Gamma + 1/6[\bar{2}110])_{(0\bar{1}10)} + (1/6[2\bar{1}\bar{1}6] + A\Phi\Gamma + 1/6[2\bar{1}\bar{1}6])_{(\bar{2}201)} \rightarrow (1/6[\bar{2}110] + A\Phi\Gamma)_{(0\bar{1}10)} + [0001]_{[\bar{2}116]} + (A\Phi\Gamma + 1/6[2\bar{1}\bar{1}6])_{(\bar{2}201)};$$
(10)

$$(1/6[1\bar{2}10] + A\Phi\Gamma + 1/6[1\bar{2}10])_{(\bar{1}010)} + (1/6[\bar{2}116] + A\Phi\Gamma)$$

$$+ 1/6[\bar{2}116])_{(2\bar{2}01)} \rightarrow (1/6[1\bar{2}10] + A\Phi\Gamma)_{(\bar{1}010)}$$

+ 1/6[\bar{1}\bar{1}26]_{[\bar{1}2\bar{1}6]} + (A\Phi\Gamma + 1/6[\bar{2}116])_{(\bar{2}201)}; (11)

)

Номер	Вектор Бюргерса	Ось результирующей	Ожидаемая плоскость
реакции	результирующей дислокации	дислокации	разрушения
(10) (11) (12) (13) (14)	$[0001] \\ 1/6[\bar{1}\bar{1}26] \\ 1/6[\bar{1}\bar{1}26] \\ [0001] \\ 1/6[\bar{1}\bar{1}26]$	$\begin{array}{c} [\bar{2}116] \\ [\bar{1}2\bar{1}6] \\ [\bar{1}2\bar{1}0] \\ [\bar{2}116] \\ [\bar{1}2\bar{1}3] \end{array}$	(0001) ~ $(03\bar{3}1)$ Трещина не образуется (0001) ~ $(\bar{1}\bar{2}32)$

Таблица 3. Дислокационные реакции и ожидаемые плоскости разрушения при взаимодействии а-сверхдислокаций плоскости призмы и 2с + а-сверхдислокаций плоскостей пирамиды I и II типа

$$(1/6[1\bar{2}10] + A\Phi\Gamma + 1/6[1\bar{2}10])_{(\bar{1}010)} + (1/6[\bar{2}116] + A\Phi\Gamma + 1/6[\bar{2}116])_{(20\bar{2}1)} \rightarrow (1/6[1\bar{2}10] + A\Phi\Gamma)_{(\bar{1}010)} + 1/6[\bar{1}\bar{1}26]_{[\bar{1}2\bar{1}0]} + (A\Phi\Gamma + 1/6[\bar{2}116])_{(\bar{2}021)}.$$
(12)

Векторы Бюргерса и направления линий результирующих дислокаций, а также ожидаемые плоскости разрушения представлены в табл. 3. Для реакции (12) результирующая дислокация с вектором Бюргерса 1/6[1126] и осью [1210] является подвижной в плоскости пирамиды I типа (2021).

При взаимодействии **a**-сверхдислокации в плоскости призмы и 2**c** + **a**-сверхдислокации в плоскости пирамиды II типа возможны две различные дислокационные реакции:

$$(1/6[\bar{2}110] + A\Phi\Gamma + 1/6[\bar{2}110])_{(0\bar{1}10)} + (1/6[2\bar{1}\bar{1}6] + A\Phi\Gamma + 1/6[2\bar{1}\bar{1}6])_{(2\bar{1}\bar{1}1)} \rightarrow (1/6[\bar{2}110] + A\Phi\Gamma)_{(0\bar{1}10)} + [0001]_{[\bar{2}116]} + (A\Phi\Gamma + 1/6[1\bar{1}\bar{1}6])_{(2\bar{1}\bar{1}1)};$$
(13)

$$(1/6[1\bar{2}10] + A\Phi\Gamma + 1/6[1\bar{2}10])_{(\bar{1}010)} + (1/6[\bar{2}116] + A\Phi\Gamma + 1/6[\bar{2}116])_{(2\bar{1}\bar{1}1)} \rightarrow (1/6[1\bar{2}10] + A\Phi\Gamma)_{(\bar{1}010)} + 1/6[\bar{1}\bar{1}26]_{[\bar{1}2\bar{1}3]} + (A\Phi\Gamma + 1/6[\bar{2}116])_{(2\bar{1}\bar{1}1)}.$$
(14)

В обоих случаях результирующая дислокация представляет дислокационный барьер. Таким образом, при взаимодействии **a**-сверхдислокаций плоскости призмы и $2\mathbf{c} + \mathbf{a}$ -сверхдислокаций плоскостей пирамиды I и II типа возможно зарождение микротрещины в плоскостях базиса (0001) и в пирамидальных плоскостях (03 $\overline{3}1$) и ($\overline{1}\overline{2}32$).

2.4. Дислокационные реакции между 2c + a-сверхдислокациями в различных плоскостях пирамиды I или II типа. При взаимодействии 2c + a-сверхдислокации в плоскостях пирамиды I и/или II типа реализуются 17 различных вариантов дислокационных реакций. Простейшей реакцией взаимодействия (два различных варианта) является реакция аннигиляции винтовых сверхдислокаций противоположного знака. Два варианта взаимодействия 2c + а-сверхдислокаций приводят к образованию а-сверхдислокации, скользящей в плоскости базиса:

$$(1/6[11\bar{2}6] + A\Phi\Gamma + 1/6[11\bar{2}6]) + (1/6[11\bar{2}6]) + A\Phi\Gamma + 1/6[11\bar{2}6]) \rightarrow (1/6[11\bar{2}6] + A\Phi\Gamma) + 1/3[11\bar{2}0] + (A\Phi\Gamma + 1/6[11\bar{2}6]).$$
(15)

Если взаимодействующие $2\mathbf{c} + \mathbf{a}$ -сверхдислокации принадлежат плоскостям ($\bar{2}021$) и ($20\bar{2}1$), ось результирующей дислокации совпадает с направлением [$1\bar{2}10$], т.е. в плоскости базиса будет скользить 60° **a**-сверхдислокация. В другом варианте плоскости скольжения реагирующих $2\mathbf{c} + \mathbf{a}$ -сверхдислокаций — ($\bar{1}\bar{1}21$) и ($11\bar{2}1$); на линии их пересечения образуется краевая **a**-сверхдислокация. Скольжение **a**-сверхдислокации в плоскости базиса ослабляет ее противодействие оставшимся в исходных плоскостях пирамиды $\mathbf{c} + \mathbf{a}/2$ -сверхчастичным дислокациям, что приводит к их рекомбинации и образованию второй **a**-сверхдислокации в плоскости базиса. В результате на линии пересечения плоскостей не остается какой-либо дислокации; таким образом, эта реакция не приводит к образованию барьера.

Еще два варианта, при которых не образуется дислокационного барьера, соответствуют следующей дислокационной реакции между $2\mathbf{c} + \mathbf{a}$ -сверхдислокациями, принадлежащими либо плоскостям пирамиды I и II типа ($(20\bar{2}1)$ и ($11\bar{2}1$)), либо двум плоскостям I типа ($(20\bar{2}1)$ и ($02\bar{2}1$)):

$$(1/6[\bar{1}\bar{1}26] + A\Phi\Gamma + 1/6[\bar{1}\bar{1}26]) + (1/6[2\bar{1}\bar{1}\bar{6}] + A\Phi\Gamma + 1/6[2\bar{1}\bar{1}\bar{6}]) \rightarrow (1/6[\bar{1}\bar{1}26] + A\Phi\Gamma) + 1/6[1\bar{2}10]_{[\bar{1}\bar{1}26]} + (A\Phi\Gamma + 1/6[2\bar{1}\bar{1}\bar{6}]).$$
(16)

Вектор Бюргерса $1/6[1\bar{2}10]$ и направление $[1\bar{1}26]$ результирующей дислокации в обоих случаях лежат в плоскости ($20\bar{2}1$). На эту дислокацию со стороны двух других $\mathbf{c} + \mathbf{a}/2$ -сверхчастичных дислокаций, ограничивающих полосу АФГ в плоскостях пирамиды, действуют напряжения отталкивания, стремящиеся продвинуть результирующую $\mathbf{a}/2$ -сверхдислокацию в плоскости ($20\bar{2}1$), которая является для этой дислокации единственно возможной плоскостью скольжения (содержит

Таблица	4.	Дислокационные	реакции	И	ожидаемые	плоскости	разрушения	при	взаимодействии	$2\mathbf{c} + \mathbf{a}$ -сверхдислокаций
плоскостей	і пи	рамиды								

Номер реакции	Системы с реагирующих	кольжения с дислокаций	Вектор Бюргерса результирующей дислокации	Ось результирующей дислокации	Ожидаемая плоскость разрушения
(1)	$1/3[11\bar{2}6](\bar{2}021)$	$1/3[2\bar{1}\bar{1}\bar{6}](\bar{2}02\bar{1})$	[1010]_	[1210]	(1010)
(2)	1/3[1126](2021)	1/3[1126](0221)	2*1/3[1120]	[1102]	(1120)
(3)	$1/3[11\bar{2}6](\bar{2}021)$	$1/3[\bar{1}2\bar{1}\bar{6}](02\bar{2}1)$	$[01\bar{1}0]$	[1102]	$\sim (13\bar{4}1)$
(4)	1/3[1126](2021)	$1/3[\bar{1}2\bar{1}\bar{6}](\bar{2}201)$	$[01\bar{1}0]$	$[2\bar{1}\bar{1}6]$	(0110)
(5)	$1/3[11\bar{2}6](\bar{2}021)$	$1/3[1\bar{2}1\bar{6}](2\bar{2}01)$	$1/3[2\bar{1}\bar{1}0]$	[0112]	$(2\bar{1}\bar{1}0)$
(6)	$1/3[\bar{1}\bar{1}26](11\bar{2}1)$	$1/3[1\bar{2}1\bar{6}](1\bar{2}11)$	[0110]	[2113]	(0110)
(7)	$1/3[\bar{1}\bar{1}26](11\bar{2}1)$	$1/3[1\bar{2}1\bar{6}](1\bar{2}1\bar{1})$	1/3[2110]	0113	(2110)
(8)	$1/3[\bar{1}\bar{1}26](11\bar{2}1)$	$1/3[\bar{1}\bar{1}2\bar{6}](\bar{2}021)$	2*1/3[1120]	5726	$\sim (8.3.11.1)$
(9)	$1/3[\bar{1}\bar{1}26](11\bar{2}1)$	$1/3[\bar{2}11\bar{6}](\bar{2}021)$	[1010]	5726	(6391)
(10)	$1/3[\bar{1}\bar{1}26](11\bar{2}1)$	$1/3[\bar{1}2\bar{1}\bar{6}](\bar{2}201)$	1/3[2110]	$[1.\overline{5}.4.12]$	(15.6.9.1)
(11)	1/3[1126](1121)	$1/3[\bar{2}11\bar{6}](\bar{2}201)$	[1010]	[1.5.4.12]	$\sim (11\overline{2}1)$

Таблица 5. Силовые и энергетические параметры дислокационных реакций

Номер реакции	Системы скольжения	L	b _{str}	$ ilde{\Psi}(m{b}_1,m{b}_2)$	$ ilde{\Psi}(m{b}_1,m{b}_{str})$	$\tilde{\Psi}(\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_{str})$	N_1	N_2
(1)	$\frac{1/6[\bar{2}110](0001)}{1/6[2\bar{1}\bar{1}6](\bar{2}111)}$	[0110]	[0001]	-0.40	0	1.448	0	73
(2)	$\frac{1/6[\bar{2}110](0001)}{1/6[1\bar{2}16](\bar{1}2\bar{1}1)}$	[1010]	1/6[1126]	-0.125	0.081	1.572	11	79
(3)	$\frac{1/6[\bar{2}110](0\bar{1}10)}{1/6[2\bar{1}\bar{1}6](\bar{2}201)}$	[2116]	[0001]	-0.726	-0.267	1.024	0	135
(4)	$\frac{1/6[1\bar{2}10](\bar{1}010)}{1/6[\bar{2}116](2\bar{2}01)}$	[1216]	1/6[1126]	~ 0	0.495	0.998	65	50
(5)	$1/6[11\bar{2}6](\bar{2}021)$	[0112]	1/3[2110]	-0.661	0.549	0.549	28	28
(6)	$\frac{1/6[\bar{1}\bar{1}26](11\bar{2}1)}{/6[\bar{1}2\bar{1}\bar{6}](\bar{2}021)}$	[0113]	1/3[2110]	-0.540	0.457	0.457	23	23
(7)	$\frac{1/6[\bar{1}\bar{1}26](11\bar{2}1)}{1/6[\bar{2}116](\bar{2}201)}$	[0113]	[1010]	-0.147	1.849	1.861	243	94

Примечание. L — вектор, направленный вдоль линии пересечения плоскостей скольжения реагирующих дислокаций; \mathbf{b}_{str} — вектор Бюргерса вершинной дислокации; $\tilde{\Psi}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$, $\tilde{\Psi}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_{str})$, $\tilde{\Psi}(\mathbf{b}_2, \mathbf{b}_{str})$ — параметры, характеризующие силу взаимодействия между дислокациями различного типа; N_1, N_2 — число дислокаций в скоплениях.

вектор Бюргерса и ось). а/2-сверхдислокация ограничивает полосу АФГ при движении в плоскости (2021). Расчет показал [19], что энергия образующейся АФГ достаточно низка ($\xi = 78 \text{ mJ/m}^2$). Таким образом, движение а-сверхдислокации в плоскости пирамиды I типа возможно, несмотря на то что обычно в процессе пластической деформации скольжение а-сверхдислокаций наблюдается только в плоскостях базиса и призмы. Анализ показывает, что в случае термически активированного превращения скользящих 2с + а-сверхдислокаций в барьеры реакции взаимодействия (15), (16) не реализуются.

Остальные 11 возможных вариантов взаимодействия 2**c** + **a**-сверхдислокаций в плоскостях пирамиды приводят к образованию дислокационных барьеров и зародышевых микротрещин. Векторы Бюргерса, оси результирующих дислокаций и ожидаемые плоскости раскрытия микротрещин представлены в табл. 4.

Во всех приведенных выше реакциях рассмотрено взаимодействие между притягивающимися дислокациями, так что образование результирующей вершинной дислокации является энергетически выгодным. Следующий шаг при образовании микротрещин предполагает взаимодействие вершинной дислокации со следующими дислокациями в скоплении. Хотя на первом шаге образования микротрещины мы рассматривали взаимодействие между притягивающимися ($\tilde{\Psi}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2) < 0$) дислокациями, на втором шаге взаимодействия чаще всего наблюдается отталкивание ($\tilde{\Psi}(\mathbf{b}_{1(2)}, \mathbf{b}_{str}) > 0$) между вершинной дислокациями скоплений $\mathbf{b}_{1(2)}$ на пересекающихся плоскостях сколь-

Область на стереографическом треугольнике	Типичная ориентация осей деформирования	Фактор Шмида	Система скольжения
Ι	[3215]	0.49 0.28 0.35	$\begin{array}{c} [\bar{2}110](0001) \\ [1\bar{2}10](\bar{1}010) \\ [11\bar{2}6](\bar{2}021) \end{array}$
Π	[3210]	0.17 0.50 0.31 0.43 0.43 0.43	$\begin{array}{c} [\bar{2}110](0001)\\ [1\bar{2}10](\bar{1}010)\\ [11\bar{2}0](\bar{1}100)\\ [\bar{2}116](2\bar{1}\bar{1}1)\\ [\bar{2}116](2\bar{2}01)\\ [2\bar{1}\bar{1}6](\bar{2}111) \end{array}$
III	[4313]	0.32 0.43 0.49 0.42	$\begin{array}{l} [\bar{2}110](0001)\\ [1\bar{2}10](\bar{1}010)\\ [\bar{2}116](2\bar{2}01)\\ [\bar{2}110](0001) \end{array}$
IV	[2117]	0.10 0.49	$\begin{array}{c} [1\bar{2}10](\bar{1}010)\\ [11\bar{2}6](\bar{2}021) \end{array}$
V	[2.1.1.12]	$\begin{array}{c} 0.24\\ 0.04\\ 0.49\\ 0.49\\ 0.47\\ 0.46\\ 0.46\\ 0.43\\ 0.43\end{array}$	$\begin{array}{c} [\bar{2}110](0001)\\ [\bar{2}110](0\bar{1}10)\\ [11\bar{2}6](\bar{2}021)\\ [1\bar{2}16](2\bar{2}01)\\ [2\bar{1}16](\bar{2}201)\\ [2\bar{1}16](\bar{2}111)\\ [11\bar{2}6](\bar{1}121)\\ [1\bar{2}16](2\bar{2}01)\\ [1\bar{2}16](\bar{1}2\bar{1}1)\end{array}$
VI	[5415]	0.38 0.39 0.46 0.45	$\begin{array}{l} [\bar{2}110](0001)\\ [1\bar{2}10](\bar{1}010)\\ [\bar{2}116](2\bar{2}01)\\ [1\bar{2}16](2\bar{2}01)\end{array}$

Таблица 6. Ориентации осей деформирования и максимальные факторы Шмида для базисной, призматических и пирамидальных систем скольжения

жения. В табл. 5 представлены энергетические параметры для дислокационных реакций (8)–(11) (строки 1–4 табл. 5) между сверхдислокациями **a**- и 2**c** + **a**-типа и реакций, представленных в строках 5, 10, 11 табл. 4 (строки 5–7 табл. 5) между 2**c** + **a**-сверхдислокациями в пирамидальных плоскостях, которые являются наиболее энергетически невыгодными из всех рассмотренных дислокационных взаимодействий вершинной дислокации с ближайшими к ней дислокациями скоплений. Из сравнения величин $\tilde{\Psi}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$ и $\tilde{\Psi}(\mathbf{b}_{1(2)}, \mathbf{b}_{str})$ видно, что в большинстве случаев рекомбинация между дислокациями скоплений и вершинной дислокацией может происходить только в поле напряжений других дислокаций скоплений при выполнении условия [15]:

$$N_{1(2)}\tau > E_{\max}/b_{1(2)},\tag{17}$$

где $N_{1(2)}$ — число сверхдислокаций в скоплениях, $\tau = 1.3 \cdot 10^9 \,\text{N/m}^2$ [3,4] — внешнее приложенное сдвиговое напряжение, $F_{\text{max}} = \psi(\mathbf{b}_{1(2)}, \mathbf{b}_{\text{str}})/c_0$. Как и в [15], при расчетах c₀ принималась равной 0.5b₁₍₂₎, $G = 7.18 \cdot 10^{10} \,\text{N/m}^2$, $\nu = 0.236$ — модуль сдвига и коэффициент Пуассона для Ti₃Al [19]. Скопления из N₁₍₂₎-дислокаций (8 и 9 столбцы в табл. 5) создают напряжения, необходимые для рекомбинации вершинной дислокации с дислокациями скоплений. Экспериментальные исследования [13] показали, что число дислокаций в скоплениях составляет величину N < 50. Этому условию удовлетворяют дислокационные реакции (10), (11) (табл. 4) между 2с + а-сверхдислокациями в плоскостях пирамиды (строки 5,6, табл. 5). Отметим, что при взаимодействии а и 2с + а-сверхдислокаций (строки 1-3, табл. 5) рекомбинация а-сверхдислокаций с вершинной дислокацией происходит существенно легче $(N_1 < N_2)$. В этих случаях образование микротрещины происходит в два этапа. На первом этапе происходит рекомбинация а-сверхдислокаций с вершинной дислокацией. Вектор Бюргерса вершинной дислокации изменяется, что существенно облегчает процесс рекомбинации 2c + а-сверхдислокации с вершинной дислокацией, т.е. микротрещина образуется. Оценки показывают, что в остальных, не представленных в табл. 5 вариантах дислокационных реакций число дислокаций в скоплениях, необходимых для образования микротрещин, мало и велика вероятность образования микротрещин. В случае дислокацинной реакции (11) (табл. 4) (строка 7, табл. 5) развития микротрещины не происходит, поскольку протяженные скопления с N > 50 экспериментально не наблюдались.

3. Ориентационная зависимость разрушения

На рис. 3 на стандартной стереографической проекции сверхструктуры DO19 выделены области, каждая из которых характеризуется определенным типом взаимодействующих дислокаций двух систем скольжения и определяет возможность образования микротрещины. В табл. 6 приведены ориентации осей деформирования и максимальные факторы Шмида для базисной, призматических и пирамидальных систем скольжения. В области І ориентаций первичной системой скольжения является $1/3[\bar{2}110](0001)$ (фактор Шмида f = 0.49). Факторы Шмида в призматических и пирамидальных системах существенно ниже, поэтому взаимодействие между базисными и другими типами систем скольжения является маловероятным. В работах [9,10,24,25] экспериментально наблюдалось образование микротрещин сдвигового типа в плоскости базиса; в [9] предложена модель образования таких микротрещин, учитывающая особенности структуры ядра винтовых а-сверхдислокаций в полосе скольжения плоскости базиса. Таким образом, если ось деформации монокристаллического ТізА1 принадлежит области I стереографического треугольника, можно ожидать образования микротрещин сдвигового типа в плоскости базиса.

Для области II первичной системой скольжения с высоким фактором Шмида $f \sim 0.5$ является призматическое скольжение $1/3[1\bar{2}10](\bar{1}010)$. Вторичной системой является также призматическое скольжение $1/3[11\bar{2}0](\bar{1}100), f = 0.31$. Фактор Шмида в плоскости базиса существенно ниже. В плоскостях пирамиды



Рис. 3. Стереографический треугольник [0001]–[1100]–[2110] для сверхструктуры *DO*₁₉. Отмечены области (I–VI), которые различаются типом взаимодействующих систем скольжения.

фактор Шмида достигает значения f = 0.43, однако пирамидальное скольжение, скорее всего, не реализуется, так как предел текучести в плоскостях пирамиды в ~ 5–10 раз выше, чем в плоскостях призмы. Для ориентации осей деформирования в пределах области II стереографического треугольника деформация до разрушения велика, может достигать $\varepsilon ~ 250\%$ [3].

Для области III стереографического треугольника (рис. 3) высокий фактор Шмида отвечает пирамидальной $(f \sim 0.49)$ и призматической $(f \sim 0.43)$ системам скольжения. Пирамидальное скольжение не реализуется в результате тех же причин, которые обсуждались при анализе области II. Вторичной системой скольжения для области III является базисное скольжение 1/3[2110](0001). Расчет, проведенный в разделе 2 (реакция (5)), показал, что микротрещины на пересечении базисной и призматической систем скольжения не образуется. Так как плоскость призмы относится к первичной системе скольжения, деформация велика. После начала работы вторичной базисной системы скольжения можно ожидать образования в плоскости базиса микротрещин сдвигового типа по механизму, действующему в области І.

В области IV (рис. 3) из-за низкого значения фактора Шмида отсутствует призматическое скольжение. Деформация в этой области ориентировок осуществляется скольжением **a**-сверхдислокаций в плоскости базиса и $2\mathbf{c} + \mathbf{a}$ -сверхдислокаций в плоскости пирамиды I типа (табл. 6). Реакция (7) между дислокациями этих систем скольжения может приводить к образованию зародышевых микротрещин нормального отрыва в плоскости базиса (табл. 2); можно ожидать также появления в этой плоскости микротрещин сдвигового типа.

В области V ориентировок вблизи направления [0001] на стереографическом треугольнике (рис. 3) факторы Шмида в базисных и призматических системах скольжения близки к нулю, деформация осуществляется пирамидальным скольжением 2**с** + **а**-сверхдислокаций. Все возможные реакции взаимодействия между дислокациями пирамидальных систем скольжения, указанными в табл. 6 для V области, описываются 2, 3, 6-8, 10, 11 строками табл. 4. Ожидаемой плоскостью разрушения в пяти вариантах являются плоскости призмы $\{hk - (h+k)0\}$. Расчет показал [26], что напряжение отрыва в этих плоскостях велико, поэтому раскрытие микротрещин затруднено. Экспериментально также не наблюдается [24,25] распространение трещин по плоскостям призмы. Таким образом, в области V ориентаций на стереографическом треугольнике возможно образование микротрещин по плоскостям пирамиды $\{13\overline{4}1\}$ и $\{11\overline{2}1\}$.

В области VI стереографического треугольника работают одновременно базисное, призматическое и пирамидальное скольжения. Микротрещины могут образовываться в результате взаимодействия **а**-сверхдислокаций плоскостей базиса или призмы и $2\mathbf{c} + \mathbf{a}$ -сверхдислокаций плоскостей пирамиды I типа. Реакции взаимодействия (6)–(9) приводят к образованию микротрещин в плоскостях базиса (табл. 2).

4. Заключение

Электронно-микроскопическое исследование образцов после деформации индентором [13] показало возможность образования микротрещин в плоскостях базиса и пирамиды в результате взаимодействия сверхдислокаций различных систем скольжения. В настоящей работе рассмотрены все возможные реакции взаимодействия между сверхдислокациями, осуществляющими деформацию в монокристаллическом Ti₃Al. Обнаружено, что взаимодействие а-сверхдислокаций, скользящих в плоскостях базиса или призмы, не приводит к образованию дислокационных барьеров — зародышей микротрещин (табл. 1). Установлено, что при взаимодействии а-сверхдислокаций плоскости базиса и 2c + a-сверхдислокаций плоскостей пирамиды I и II типа возможной плоскостью разрушения является плоскость базиса (0001) (табл. 2). При взаимодействии а-сверхдислокаций плоскости призмы и 2с + а-сверхдислокаций плоскостей пирамиды возможными плоскостями разрушения являются плоскости базиса и пирамиды (табл. 3). Показано, что взаимодействие 2с + а-сверхдислокаций, относящихся к различным плоскостям пирамиды I и/или II типа, приводит к образованию микротрещин в плоскостях призмы и пирамиды.

Классификация типов микротрещин, образующихся при взаимодействии дислокаций, позволила выделить пять областей ориентаций осей деформирования монокристаллов (рис. 3). Вблизи линии [1100]–[2110] стереографического треугольника (область II) можно ожидать высокой степени деформации до разрушения, так как дислокационные взаимодействия не приводят к образованию дислокационных барьеров. В узкой области (< 10⁰) ориентаций вблизи [0001] (область V) взаимодействия 2с + а-сверхдислокаций приводят к раскрытию микротрещин в плоскостях пирамиды. В остальной части стереографического треугольника микротрещины образуются преимущественно в плоскости базиса; в областях II, III — сдвигового типа; в областях I, IV — трещины как сдвигового типа, так и нормального раскрытия.

В реакциях (6)–(16) дислокации, вступающие в реакцию, рассматривались скользящими. Экспериментальными исследованиями [14,15] и теоретическими расчетами [17,27] показана возможность термоактивированного превращения скользящих конфигураций $2\mathbf{c} + \mathbf{a}$ -сверхдислокаций в дислокационные барьеры. Установлено, что в плоскостях пирамиды I типа заблокированные $2\mathbf{c} + \mathbf{a}$ -сверхдислокации с осью $\langle 11\bar{2}0 \rangle$ наблюдаются при температурах $T \sim 300-400$ K, в плоскостях пирамиды II типа наблюдается блокировка $2\mathbf{c} + \mathbf{a}$ -сверхдислокаций вонтовой ориентации вблизи температуры пика ($T \sim 800 K$) на кривой $\sigma_y(T)$ [7,24]. В реакциях (6), (7) ось результирующей дислокации совпадает с направлением линии $2\mathbf{c} + \mathbf{a}$ -сверхдислокации в заблокированной конфигурации в плоскости пирамиды

I типа, поэтому эти дислокационные реакции справедливы и для температурного интервала 300-400 К. Для реакций (8), (9) линия пересечения плоскостей базиса и пирамиды II типа $(1\bar{1}00)$ не совпадает с направлением оси заблокированной дислокации; а-сверхдислокация не может испытывать поперечного скольжения из плоскости базиса в плоскость пирамиды II типа, поэтому реакции (8),(9) вблизи температуры пика не реализуются. При взаимодействии 2с + а-сверхдислокаций, принадлежащих различным плоскостям пирамиды I и/или II типа, в температурных интервалах блокировки 2c + aсверхдислокаций (в области аномального возрастания предела текучести с температурой) возможна реализация только реакции (13). В этом случае линия пересечения плоскостей скольжения реагирующих дислокаций параллельна оси заблокированной винтовой 2с + асверхдислокации в плоскости пирамиды II типа.

В рассмотренной модели плоскость образующейся зародышевой микротрещины определяется векторами Бюргерса и плоскостями скольжения взаимодействующих дислокаций. В этой модели не учитывается легкость раскрытия трещины в полученной плоскости и ее способность к распространению. Количественно эти характеристики могут быть учтены, например, в модели Райса-Томпсона при сопоставлении энергии декогезии, которая характеризует склонность материала к раскрытию, и энергии нестабильного дефекта упаковки, определяющего склонность материала к пластической релаксации. Для Ti₃Al эти параметры были определены в [26] с использованием метода молекулярной динамики для всех экспериментально наблюдаемых плоскостей скола и систем скольжения. Вычислены энергии декогезии G_c в плоскостях базиса (0001), призмы (1100) и (1120), пирамиды $\{10\overline{1}2\}, \{\overline{1}\overline{1}23\}, \{10\overline{1}1\}, \{11\overline{2}1\}$ и $\{20\overline{2}1\}.$ Установлено, что энергия декогезии изменяется в пределах $G_c = 2060 - 3170 \text{ mJ/m}^2$. Изучены γ -поверхности и получены значения энергий нестабильных дефектов упаковки $\gamma_{\rm us}$ для сдвига $\langle 1\bar{1}00 \rangle$ в плоскости базиса, сдвигов $\langle \bar{1}\bar{1}20 \rangle$ в плоскостях базиса и призмы, сдвига $\langle \bar{1}\bar{1}26 \rangle$ в плоскостях пирамиды. Установлено, что энергии нестабильных дефектов упаковки изменяются в пределах $y_{\rm us} = 409 - 3608 \, {\rm mJ/m}^2$ при переходе от плоскости базиса к плоскостям пирамиды. В модели Райса-Томпсона и Келли изучено соотношение между склонностью к разрушению и способностью к пластической релаксации интерметаллида ТізАl. Вычислены значения безразмерного параметра q, характеризующего меру хрупкого поведения материала. Получены значения q = 0.6 - 2.0для случая формирования пластической зоны скольжением частичных дислокаций Шокли 1/6(1100) в плоскости базиса. При скольжении полных а- и 2с + асверхдислокаций в плоскостях базиса, призмы и пирамиды q = 1.5 - 9.5. Высокие значения q свидетельствуют о внутренней природе хрупкости интерметаллида ТізАl. В частности, показано [26], что в плоскостях базиса и пирамиды $\{\overline{1}011\}, \{\overline{1}\overline{1}23\}, \{\overline{1}012\}, \{20\overline{2}1\}\ q$ имеет наиболее высокое значение, т.е. раскрытие трещины происходит легко. Как показано в настоящей работе, именно в этих плоскостях наблюдается образование зародышевых микротрещин. Таким образом, для плоскостей (0001), {2021} плоскости микро- и макротрещин совпадают, в других случаях возможно изменение поверхности макроскола.

Список литературы

- J.S. Kim, D.H. Shin, Y.W. Chang, C.S. Lee. Mat. Sci. Eng. 394, 117 (2005).
- [2] Y. Umakoshi, T. Nakano, T. Takenaka, K. Sumimoto, T. Yamane. Acta Met. Mater. 41, 1149 (1993).
- [3] Y. Minonishi. Phil. Mag. A 63, 1085 (1991).
- [4] Y. Minonishi, M.N. Yoo. Phil. Mag. Lett. 61, 203 (1990).
- [5] Е.В. Панова, Л.Е. Карькина, Е.П. Романов. ФММ 75, 166 (1993).
- [6] Y. Minonishi, M. Otsuka, K. Tanaka. In: Proc. of Int. Symp. on Intermetallic compounds structure and mechanical properties. Sendai, Japan (1991). P. 543.
- [7] Y. Umakoshi, T. Nakano, B.Ogawa. Scripta Mater. 34, 1161 (1996).
- [8] D. Farkas. MRS Bull. May, 35 (2000).
- [9] L. Yakovenkova, S. Malinov, T. Novoselova, L. Karkina. Intermetallics 12, 599 (2004).
- [10] L. Yakovenkova, S. Malinov, L. Karkina, T. Novoselova. Scripta Mater. 52, 1033 (2005).
- [11] Л.И. Яковенкова, Л.Е. Карькина, М.Я. Рабовская. ЖТФ 73, 60 (2003).
- [12] Л.И. Яковенкова, Л.Е. Карькина, М.Я. Рабовская. ЖТФ 73, 70 (2003).
- [13] Л.Е. Карькина, Л.И. Яковенкова, О.А. Елкина. ФТТ 49, 1603 (2007).
- [14] Дж. Хирт, И. Лоте. Теория дислокаций. Атомиздат, М. (1972). 599 с.
- [15] T. Kawabata, Y. Takezono, T. Kanai, O. Izumi. Acta Met. 36, 963 (1988).
- [16] L.K. Wickham, K.W. Schwarz, J.S. Stolken. Phys. Rev. Lett. 83, 4574 (1999).
- [17] Л.Е. Карькина, Л.И. Яковенкова, Е.В. Панова, М.Я. Рабовская. ФММ 85, 54 (1998).
- [18] Л.И. Яковенкова, Л.Е. Карькина, М.Я. Рабовская. Изв. АН. Сер. физ. 67, 976 (2003).
- [19] Л.И. Яковенкова, В.В. Кирсанов, Л.Е. Карькина, А.Н. Балашов, М.Я. Рабовская. ФММ 89, 237 (2000).
- [20] Л.И. Яковенкова, Л.Е. Карькина, М.Я. Рабовская. Изв. РАН. Сер. физ. 66, 891 (2002).
- [21] Л.И. Яковенкова, Л.Е. Карькина, М.Я. Рабовская. ФММ 93, 32 (2002).
- [22] S.A. Court, J.P.A. Lofvander, M.H. Loretto, H.L. Fraser. Phil. Mag. A 59, 280 (1989).
- [23] S.M.L. Sastry, H.A. Lipsitt. Acta Met. 25, 1279 (1977).
- [24] H. Inui, Y. Toda, M. Yamaguchi. Phil. Mag. A 67, 1315 (1993).
- [25] H. Inui, Y. Toda, Y. Shirai, M. Yamaguchi. Phil. Mag. A 69, 1163 (1994).
- [26] Л.Е. Карькина, Л.И. Яковенкова, М.Я. Рабовская. ЖТФ 76, 50 (2006).
- [27] Л.И. Яковенкова, Л.Е. Карькина, М.Я. Рабовская. ФММ 87, 20 (1999).